

解答上の注意

1. 問題用紙 4 枚, 答案用紙 4 枚.
2. 答案用紙にはそれぞれ氏名と学籍番号を明記すること.
3. 答案用紙は裏面を使ってもよい. その場合は「裏へ」と明記すること.
4. 答案の並びは問題番号の並びと違っていてもよい. 問題番号を明記すること.
5. 持ち込み不可.

問題 1

以下が成り立つことを示せ. ただし $\varphi(x, y, z)$ はスカラー関数, $\mathbf{A}(x, y, z)$, $\mathbf{B}(x, y, z)$ はベクトル関数とする.

$$(1) \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

$$(2) \nabla \times (\nabla \varphi) = 0$$

$$(3) \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

問題 2

円筒座標系 (r, ϕ, z) について以下の問に答えよ.

- (1) (x, y, z) を (r, ϕ, z) を用いて表せ.
- (2) スケール因子 h_r, h_ϕ, h_z を求めよ.
- (3) 直交曲線座標系 (u_1, u_2, u_3) におけるスカラー φ の勾配は

$$(\text{grad } \varphi)_{u_j} = \frac{1}{h_j} \frac{\partial \varphi}{\partial u_j}$$

と表される. ここで下付き添字 u_j は u_j 成分であることを示す. これを用いて円筒座標系における φ の勾配の各成分を表せ.

- (4) 直交曲線座標系 (u_1, u_2, u_3) におけるベクトル \mathbf{A} の発散は

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left(\frac{\partial A_1 h_2 h_3}{\partial u_1} + \frac{\partial A_2 h_3 h_1}{\partial u_2} + \frac{\partial A_3 h_1 h_2}{\partial u_3} \right)$$

と表される. これを用いて円筒座標系における \mathbf{A} の発散を表わせ.

- (5) 直交曲線座標系 (u_1, u_2, u_3) におけるベクトル \mathbf{A} の回転は

$$(\nabla \times \mathbf{A})_{u_i} = \varepsilon_{ijk} \frac{1}{h_j h_k} \frac{\partial A_k h_k}{\partial u_j}$$

と表される. ここで下付き添字 u_i は u_i 成分であることを示す. これを用いて円筒座標系における \mathbf{A} の回転の各成分を表せ.

- (6) 上記の (3), (4) の結果を利用し, 円筒座標系における

$$\nabla^2 \varphi$$

の表式を求めよ.

問題 3

次の問いに答えよ.

- (1) 電荷 q と q を囲む閉曲面 S 上における静電場 E との間には, ガウスの定理より

$$q = \int_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS$$

が成り立つ. 電荷密度を ρ とするとき,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$$

となることを示せ.

- (2) $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ のとき, 定点 O と任意の点 P を通る曲線 OP に沿った線積分

$$\int_{OP} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

は, 曲線のとり方によらず点 P の位置だけによることを示せ.

- (3) 積分形のファラデーの電磁誘導の法則は

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

と表される, ここで C は空間に固定された任意の閉曲線で, 左辺は C に沿った線積分を表し, Φ は C によって囲まれた面 S を貫く磁束である. 磁束密度を B とすると, 上記の電磁誘導の法則は

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B}$$

と表されることを示せ.

問題 4

マックスウェルの電磁方程式は以下の 4 本の式からなる.

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{I} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

ここで E, H は電場と磁場, D, B は電束密度と磁束密度, ρ は電荷密度, I は電流密度である. E と D, H と B, E と I の間には以下の関係が成り立つ.

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \varepsilon \mathbf{E}, \\ \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H}, \\ \mathbf{I} &= \sigma \mathbf{E}.\end{aligned}$$

ここで ε, μ, σ はそれぞれ誘電率と透磁率, 電気伝導率である. 以下では ε, μ, σ は定数であるとする.

- (1) E, H の満たす方程式を求めよ.
- (2) (1) において, 真空中の場合 ($\rho = 0, \sigma = 0$) の場合の方程式を求めよ.